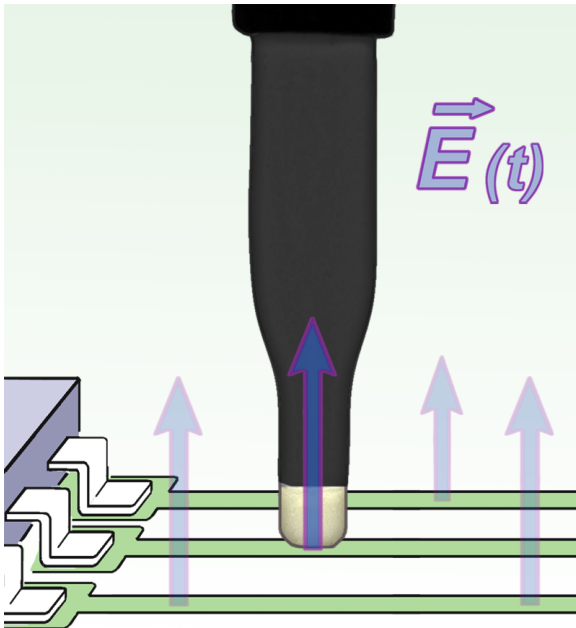


# RF-E 10

E-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz



## Kurzbeschreibung

Die Elektrode in der Unterseite des Sondenkopfes der RF-E 10 ist ca. 0,2 mm breit. Damit können kleinste E-Feldquellen lokalisiert werden, z.B. 0,1 mm breite Leiterzüge, einzelne IC-Pins an hochpoligen ICs.

Die RF-E 10 ist eine passive Nahfeldsonde. Sie besitzt den gleichen prinzipiellen Aufbau wie die Sonden RF-E 05 und RF-E 02. Die Auflösung der RF-E 10 ist jedoch wesentlich höher. Typischerweise wird der Sondenkopf direkt auf das Messobjekt aufgesetzt (hohe elektrische Feldstärke). Für Messungen in größeren Abständen wie sie mit der RF-E 05 und der RF-E 02 ausgeführt werden, ist sie nicht geeignet. Die E-Feldsonde ist klein und handlich. Sie besitzt eine Mantelstromdämpfung und die Oberseite des Sondenkopfes ist elektrisch geschirmt. Die Nahfeldsonde wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit 50  $\Omega$  Eingang angeschlossen. Die E-Feldsonde besitzt intern keinen 50  $\Omega$  Abschlusswiderstand.

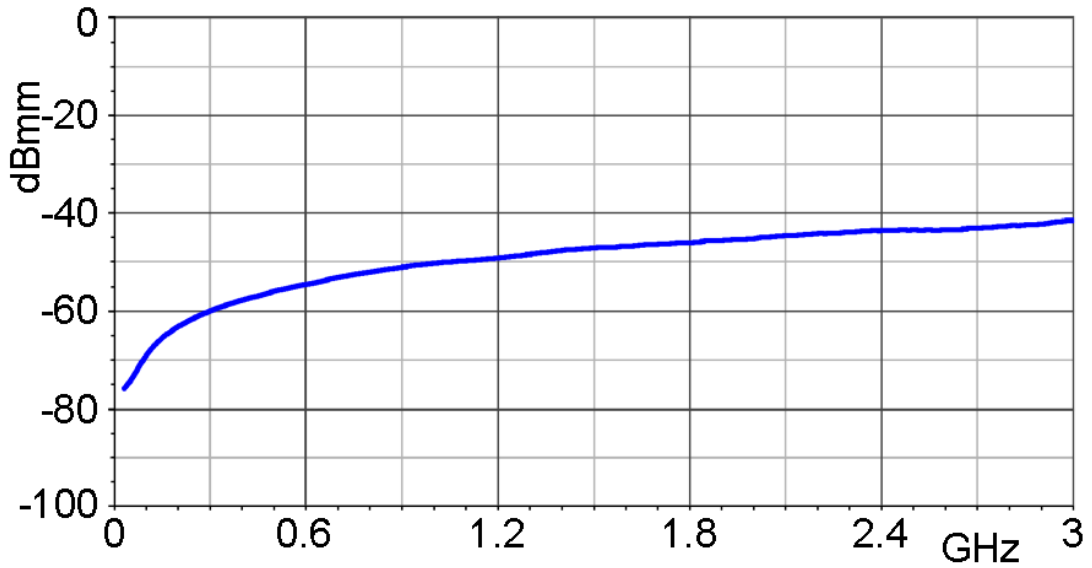
## Technische Parameter

Frequenzbereich	30 MHz ... 3 GHz
Auflösung	$\approx$ 0.2 mm
Maße Sondenkopf	$\approx$ (0.5 x 2) mm
Anschluss - Ausgang	SMB, male, jack
Gewicht	15 g

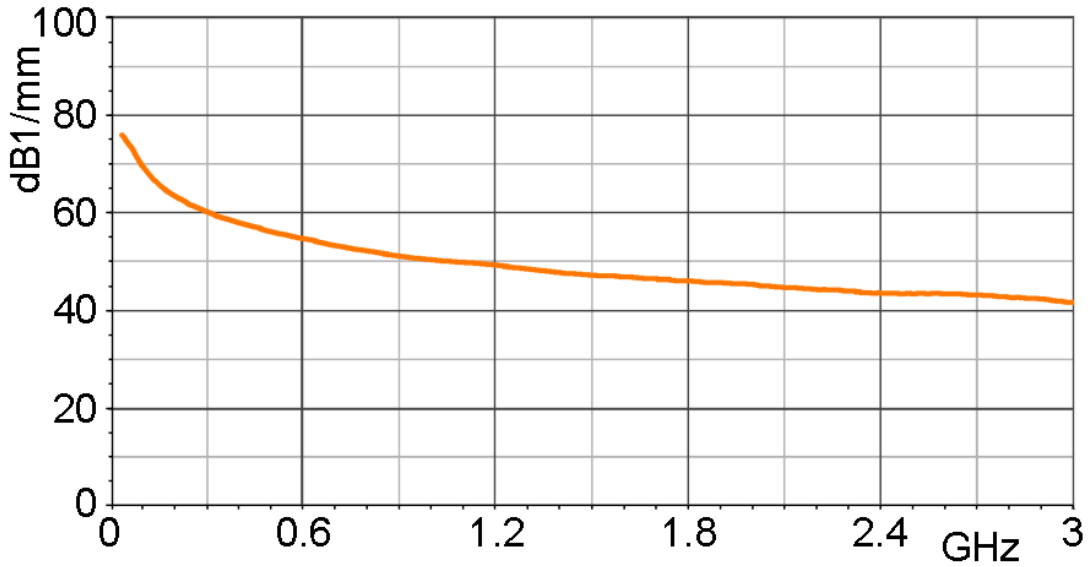
# RF-E 10

E-Feldsonde 30 MHz bis 3 GHz

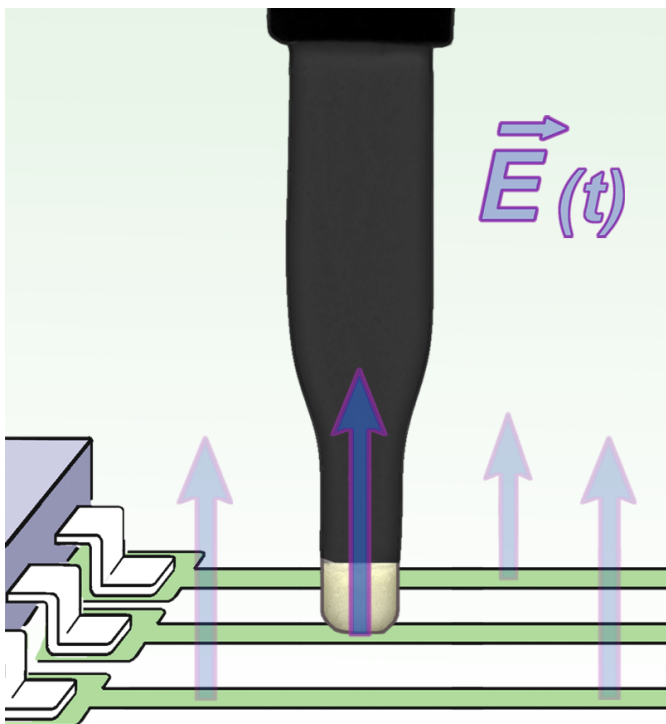
Frequenzgang [dB $\mu$ V] / [dB $\mu$ V/mm]



Korrekturkurve E-Feld [dB $\mu$ V/mm] / [dB $\mu$ V]



Messprinzip



Sondenkopf

